

国際リニアコライダーにおける 崩壊点検出器FPCCDの基本性能 および放射線耐性の研究

素粒子実験研究室 B3SM2010 伊藤 周平







<u>概要</u>

- 電子陽電子衝突型線形加速器
- 全長約31km (アップグレード後 約50km)
- 重心系エネルギー250GeV~500GeV (アップグレード後 1TeV)

<u>目的</u>

- ヒッグス粒子の精密測定
- トップ・クォークの精密測定
- 新物理の探索





ILD検出器

修士論文発表会







崩壊点検出器への要求

- ピクセル占有率(反応ピクセル数/総ピクセル数)を数%以下に抑える

読み出し方式

i)ビームトレイン中数回に分けてシグナル を読み出す ^{1トレイン~1312/バンチ}

 \rightarrow CMOS, DEPFET

ii) トレイン間隔である ^{1ms} ^{199ms} ¹ 199msの間にシグナルをすべて読み出す ^{ILCビーム構造}

FPCCD(Fine Pixel CCD: 高精細なCCD検出器)

FPCCD崩壊点検出器



修士論文発表会

FPCCD原理



<u>原理(電荷収集方法)</u> CCDは電極電圧を変化させる ことで電荷をバケツリレーのように となりのピクセルへ次々と転送していく

CCD転送様子(断面)





<u>センサー</u>

- ピクセル5μm x 5μm、有感領域15μmを目標としている。
- 現在まで6µm x 6 µm ピクセルサイズ試作器が完成



読み出し回路要求性能

大型試作器と小型試作器

- : 読み出し速度 > 10Mpixel/s(クロックパルス100MHz)
 - → 全てのピクセルをトレイン間隔で読み出すため
- : 読み出し回路ノイズ く 30 電子
- : 電力消費量 < 6mW/ch

読み出し速度 : 12Mpixel /s ノイズ : 6electrons 電力消費量: 5.8mW/ch



試作読み出し回路

FPCCD信号読み出しテスト

信号読み出し装置





PCからSEBAS上のFPGAを制御、 CCD駆動クロックを生成

恒温槽

温度依存性を測定するため、 AFFROCボードを恒温槽の中へ

PC





チャッターを開閉することで、X線の有無を調節する

CCD



6mm x 6mm 小型試作器を使用 有感領域の厚さ:15µm チャンネル数:4 2種類のセンサーを使用







信号読み出し結果

信号読み出しテスト

- まずCCD駆動パルス6MHzにおいて読み出しテストを実施



6MHz駆動パルスを用いて55FeのX線ピークを確認した

信号読み出しテスト

19





修士論文発表会

中性子照射試験前後で以下の項目を測定し、変化を測定

- ダークカレント 中性子照射によって電子ノイズがどれだけ上昇するか
- ホットピクセル 飛跡再構成に悪影響を与えるほど増加するか
- CTI(Charge trasfer inefficiency) 中性子照射によって、電荷信号転送効率がどれほど低下 するか

ダークカレント

ダークカレントは蓄積時間の長さに比例して上昇
 蓄積時間を変化させながらペデスタルピーク位置の変化測定



23

ホットピクセル

<u>ホットピクセル</u>

- X線を当てていないにも関わらず通常より高い信号をだすピクセル
 - ピクセル占有率を高めてしまい、トラッキングに悪影響を与えてしまう



全ピクセルに対してのホットピクセルの割合を測定

Charge Transfer Inefficiency(CTI)

Charge Transfer Inefficiency(CTI)

- となりのピクセルに信号を転送するときの転送非効率
 - → 読み出し口から遠いピクセルは転送回数が多くシグナルを多く 損失してしまう

計算方法 1. シングルヒットイベントを選定する。 → X線のエネルギー5.9keVのエネルギーが十分に落とされたピクセル

シングルヒットイベント



Charge Transfer Inefficiency(CTI)

- 2. 1チャンネル
 - (12μm 角CCDなら512 x 128、6μm 角なら1024 x 256 ピクセル数) を、1領域16 x 16 ピクセルとした領域で分ける
- 3. 各領域においてシングルヒットイベントを選定しガウシアンでフィット



領域(1,1)

領域(1,63)

信号読み出し口(0,0)から遠い領域ほど、転送回数 が多いためシグナルを多く損失する

修士論文発表会

Charge Transfer Inefficiency(CTI)



中性子照射試験前後において、どれほど転送効率が 低下したかを比較する

中性子照射試験



中性子照射試験



<u>概要</u>

- 東北大学CYRICにて試作FPCCD に対して中性子照射試験を実施
- 70MeVプロトンビームから約65MeV 中性子ビームを生成可 Li+p → Be+n



中性子エネルギースペクトラム[CYRIC 資料]



目的

-中性子照射前後においてFPCCDの性能がどのように変化するかを測定 - 異なるピクセルサイズを持つCCDと、6µm角CCDに対して中性子ビーム





- FPCCDに照射された中性子フラックスを測定







<u>プラスチックシンチ</u> レータ : キャリブレーション



<u>BPM(Beam Profile Monitor)</u> プラスチックシンチレーター100mm x 10mm + PMT : 中性子フラックス形状を測定



修士論文発表会





中性子ビームは ビームポートから ほぼ広がらずに 放射される

使用FPCCD	陽子ビームカ レント	照射時間	中性子フラックス
異なるピクセルサイズ	1μΑ	30分	1.02 x 10 ⁹
6µm 角FPCCD	1μΑ	2時間	4.11×10^9

シミュレーションよりILCでの中性子フラックスは1.85 x 10⁹



修士論文発表会



ダークカレント



中性子照射後(2時間照射、6μm 角、水平6μm x 24μmFPCCD)



- 照射後、ダークカレントは蓄積時間が増えるにつれて大きく増大



ダークカレント



- ペデスタルのピーク位置は大きな 変化は見られない

35



ホットピクセル

36

中性子照射前





ホットピクセル

37



Charge Transfer Inefficiency (CTI)

<u>12µm角ピクセルサイズ</u>

転送方向	中性子照射前	中性子照射後
水平方向	$(1.84 \pm 0.55) \times 10^{-6}$	$(6.39 \pm 0.63) \times 10^{-6}$
垂直方向	$(4.66 \pm 2.14) \times 10^{-6}$	$(2.83 \pm 0.25) \times 10^{-5}$

- 照射後CTIは上昇
- 垂直方向がより上昇 している。
- ·水平方向5400回、 垂直方向128回転送

 $(1 - (6.39 \times 10^{-6}))^{5400} \times (1 - (2.83 \times 10^{-5}))^{128} = 0.96$



まとめ

- 試作FPCCDの信号読み出し試験を行い垂直転送パルス
 を変更することでFe55の信号が読み出せることを確認した
 試作FPCCDに対して中性子照射試験をおこない放射線
 - 耐作FFPCCDに対して中性子照射試験をわこない放射線 耐性を評価した
- 見積もられた中性子フラックスはILC運転期間の約1.3年分
- ホットピクセル、ダークカレントは運転予定である-40℃下、 読み出し時間199ms では大きな問題とはならない と考えられる
- 6µm角FPCCDでは最も遠いピクセルで信号が約69%まで 低下する

BACK UP

修士論文発表会















修士論文発表会